

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月9日(09.09.2022)



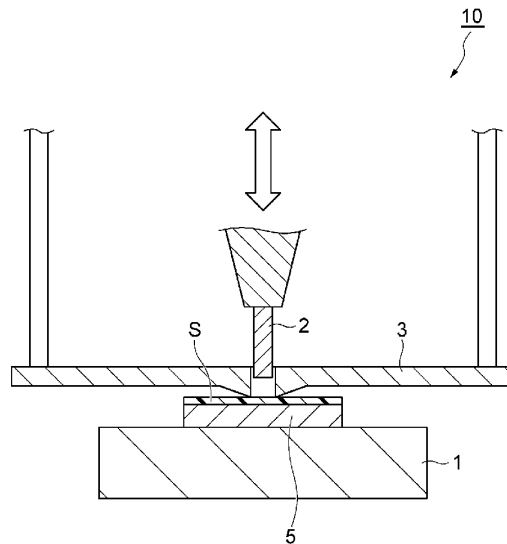
(10) 国際公開番号

WO 2022/186229 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 201/00 (2006.01) C09J 7/00 (2018.01)
H01L 21/52 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/008695
- (22) 国際出願日: 2022年3月1日(01.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-035469 2021年3月5日(05.03.2021) JP
- (71) 出願人: 昭和電工マテリアルズ株式会社 (SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.)
- [JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 田澤 強(TAZAWA Tsuyoshi); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 山本 和弘(YAMAMOTO Kazuhiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 中村 奏美(NAKAMURA Kanami); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 谷口 紘平(TANIGUCHI Kohei); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 平理子(TAIRA Ayako); 〒1006606 東京都千代田

(54) Title: BONDING FILM, METHOD FOR EVALUATING SAME, METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE AND INTEGRATED DICING/DIE BONDING FILM

(54) 発明の名称: 接着フィルム及びその評価方法、並びに、半導体装置の製造方法及びダイシング・ダイボンディング型フィルム



(57) Abstract: A method for evaluating a bonding film which is used in a production process of a semiconductor device, the method comprising a step in which a tack test is carried out by means of a heated probe. With respect to this method for evaluating a bonding film, the thickness of a bonding film to be evaluated is 20 μm or less. This tack test uses, for

[続葉有]

WO 2022/186229 A1

区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

example, an apparatus which is provided with a stage that supports a bonding film sample and a probe that is vertically movable with respect to the stage, while being able to be set to a specific temperature; and this tack test is carried out in a state where a polyimide film is interposed between the stage and the sample.

(57) 要約: 半導体装置の製造プロセスにおいて使用される接着フィルムの評価方法であって、加熱されたプローブでタック試験を行う工程を含み、評価対象の接着フィルムの厚さが20μm以下である、接着フィルムの評価方法。このタック試験は、例えば、接着フィルムの試料を支持するステージと、ステージに対して上下方向に移動自在であり且つ温度設定が可能なプローブとを備える装置を使用し、ステージと試料の間にポリイミドフィルムを介在させた状態で行われる。